

Elektronik 1 Dersi

Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi : Murat Duman

Mail: mduman@ankara.edu.tr

Ders Kitabı: *Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky-Electronic Devices and Circuit Theory (11th Edition)-Prentice Hall (2012)*

(Bu çalışmadaki şekiller ders kitabından alınmıştır)

Hafta 13

Bölüm 4. : Uygulama

Malzeme Listesi:

Silisyum diyot

Zener diyot (10 V'luk)

8 k Ω direnç, 10 k Ω direnç, 15 k Ω direnç, 20 k Ω direnç, 500 k Ω direnç, 1 M Ω direnç

100 k Ω potansiyometre, 1 M Ω potansiyometre

2N4401 BJT Transistör

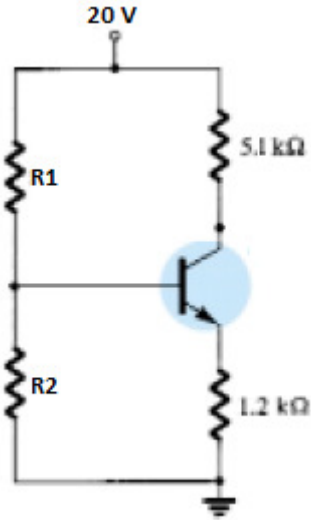
BC337 BJT Transistör

BF245 FET Transistör

Milimetrik kağıt

Bölüm 4.4. : Deney 4

Potansiyometre kullanarak V_{CE} 'yi 10 V değerine sabitlemek için gerekli R_1 ve R_2 değerlerini bulunuz. Deneyde ilk olarak 2N4401 transistör kullanınız, sonra aynı deneyi BC337 transistör ile tekrarlayınız. Verilen devrenin Thevenin eşdeğerini kullanarak β değerini hesaplayınız. Her iki transistör için de I_C and V_{CE} değerlerini ölçünüz. Bu değerler arasında büyük fark var mı açıklayınız.



Şekil 4.4. İlgili Şekil